

06.3;07

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВУХСТОРОННЕГО СОГЛАСОВАНИЯ ОДНОМОДОВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТРУКТУР И ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДОВ

*© А.С.Шербаков, Е.И.Андреева,
А.Б.Лютецкий, Н.А.Пихтин, А.Ю.Лешко*

Создание высокоскоростных волоконно-оптических систем передачи информации, использующих волоконные и полупроводниковые компоненты, требует не только разработки элементной базы, но и поиска путей оптимизации оптического согласования волноводных структур. Проблема согласования приобретает особое значение в высокоскоростных солитонных информационных системах в силу необходимости достижения максимальной мощности оптических импульсов в одномодовом волоконном световоде для реализации нелинейного режима их распространения [1]. Актуальность этой проблемы еще более возрастает в связи с появлением мощных полупроводниковых лазеров с квантово-размерной активной областью [2]. При этом большой практический интерес представляет не только задача увеличения коэффициента ввода излучения полупроводникового источника в одномодовый волоконный световод, но и повышение эффективности двухстороннего согласования световод – полупроводниковый лазер – световод, что важно для повышения коэффициента оптической обратной связи полупроводникового источника с волоконным резонатором [3,4] и при использовании полностью оптических полупроводниковых регенераторов [5,6].

Ограничение эффективности согласования полупроводникового лазера с квантово-размерной активной областью и одномодового волоконного световода обусловлено преимущественно значительным рассогласованием распределений полей в плоскости, перпендикулярной $p-p$ -переходу. Если распределение поля лазера в плоскости, параллельной $p-p$ -переходу, незначительно отличается от распределения поля на апертуре волоконного световода, использование таких согласующих элементов, как сферическая линза на торце световода или фокусирующий конус [7], приводит лишь к незначительному повышению эффективности двухстороннего согласования по сравнению с непосредственной стыковкой “в торец”. В связи с этим представляет интерес

методика оценки эффективности двухстороннего согласования пристыковке "в торец" по заданным параметрам таких волноводных структур.

Для анализа эффективности перекачки светового поля пристыковке в торец необходимо, вообще говоря, оценить степень перекрытия распределений светового поля обеих структур как по линейным, так и по угловым характеристикам. Однако учитывая, что угловая апертура лазера, как правило, превалирует над угловой апертурой световода, а также тот факт, что модовое пятно световода перекрывает модовое пятно лазера, для оценки эффективности перекачки из лазера в световод ν_{12} достаточно учесть только угловое рассогласование распределений световых полей, тогда как эффективность обратного процесса ν_{21} определяется рассогласованием размеров модовых пятен:

$$\nu_{12} = \operatorname{erf}(2^{1/2}\theta_0/\theta_\perp)\operatorname{erf}(2^{1/2}\theta_0/\theta_\parallel), \quad (1)$$

$$\nu_{21} = \operatorname{erf}(2^{1/2}\omega_\perp/\omega_0)\operatorname{erf}(2^{1/2}\omega_\parallel/\omega_0), \quad (2)$$

где ω_0 — радиус модового пятна; θ_0 — апертурный угол световода; ω_\perp и ω_\parallel — полуширины модовых пятен на выходе лазера в плоскости, перпендикулярной и параллельной $p-n$ -переходу; θ_\perp и θ_\parallel — апертурные углы в указанных плоскостях. Так как обычно $\operatorname{erf}(2^{1/2}\theta_0/\theta_\parallel) \approx 1$ и $\operatorname{erf}(2^{1/2}\omega_\parallel/\omega_0) \approx 1$, то для эффективности двухстороннего согласования получим

$$\nu = \nu_{12}\nu_{21} = \operatorname{erf}(2^{1/2}\theta_0/\theta_\perp)\operatorname{erf}(2^{1/2}\omega_\perp/\omega_0). \quad (3)$$

Фазовый объем, занимаемый в установившемся режиме световым полем, передаваемым по одномодовому волоконному световоду, представляется как

$$V_{pr} = \pi^2\omega_0^2\theta_0^2. \quad (4)$$

В слабонаправляющем световоде справедлива связь θ_0 с разницей показателей преломления сердцевины n_0 и отражающей оболочки n_e :

$$\sin \theta_0 \approx \theta_0 \approx [b_f(n_c^2 - n_s^2)]^{1/2}, \quad (5)$$

где b_f — коэффициент, совпадающий с нормированной постоянной распространения нулевой моды. Величина коэффициента b_f зависит от V -параметра световода: $V = ka(n_c^2 - n_s^2)^{1/2}$, где a — радиус сердцевины, k — волновое число. Вблизи отсечки первой высшей моды ($V = 2.4$) значение b_f

близко к единице, так что для стандартных кварцевых световодов можно положить

$$\theta_0 \approx (n_c^2 - n_s^2)^{1/2} \approx n_c(2\Delta)^{1/2}, \quad (6)$$

где $\Delta = (n_s - n_c)/n_c$ — относительная разница показателей преломления. Для определения радиуса модового пятна может быть использовано эмпирическое соотношение [8]

$$\omega_0 = a(0.65 + 1.619V^{-1.5} + 0.87V^{-6}). \quad (7)$$

Соотношения (4)–(7) позволяют выразить V_{pf} через параметры волоконного световода.

Фазовый объем светового поля в прямоугольном волноводе, каким является полупроводниковый лазер, представляется аналогично (4) с учетом эллиптичности пространственного распределения оптического излучения:

$$V_{ps} = \pi^2 \omega_\perp \omega_\parallel \theta_\perp \theta_\parallel. \quad (8)$$

Величины ω_\perp и θ_\perp определяются параметрами волновода лазера. Апертурный угол θ_\perp представляется аналогично (5)

$$\sin \theta_\perp = [b_s(n_c^2 - n_s^2)]^{1/2}. \quad (9)$$

Здесь n_c — показатель преломления волноводного слоя шириной W и толщиной d , n_s — показатель преломления окружающей волновод среды. Коэффициент b_s в данном случае значительно отличается от единицы даже вблизи отсечки первой высшей моды [9], которой соответствует значение V -параметра волновода $V = \pi/2$, здесь $V = 0.5kd(n_c^2 - n_s^2)^{1/2}$ (рис. 1, а). Размер модового пятна ω_\perp представляется соотношением

$$\omega_\perp = \frac{d}{2} \left[1 - \frac{2}{b_s^{1/2} V} \right]. \quad (10)$$

Зависимость относительного размера модового пятна $2\omega_\perp/d$ от V -параметра волновода представлена на рис. 1, а. Используя типичные для InGaAsP-лазеров на длине волны 1.55 мкм значения $n_c = 3.5$ и $\Delta = 0.09$, получим зависимости размера модового пятна $2\omega_\perp$ и апертурного угла θ_\perp от толщины волновода d (рис. 1, б). Из рис. 1 видно, что уменьшение толщины волновода влечет за собой уменьшение V -параметра и связанного с ним коэффициента b_s , что приводит к сужению диаграммы направленности излучения в плоскости, перпендикулярной $p-n$ -переходу, и возрастанию размера модового пятна ω_\perp . Параметры ω_\parallel и θ_\parallel таких лазеров определяются распределением концентрации

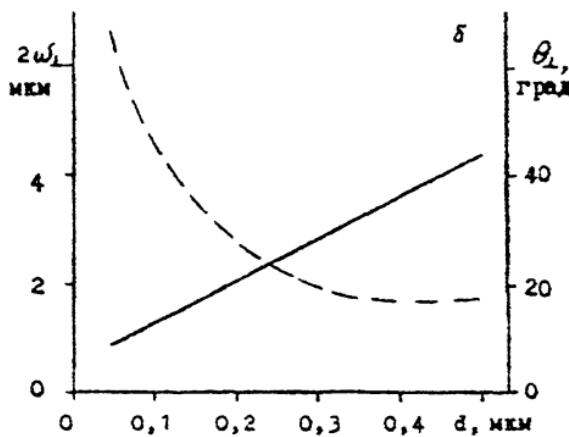
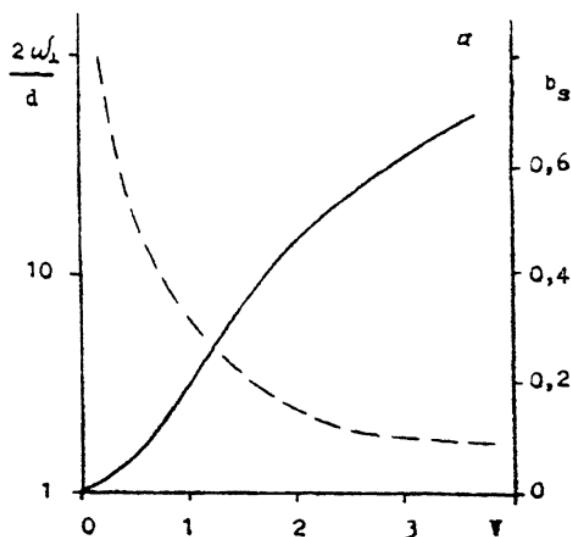


Рис. 1. Зависимости размера модового пятна (пунктир) и угла расходимости (сплошная линия) светового поля на выходе полупроводникового лазера в плоскости, перпендикулярной $p-n$ -переходу, от толщины волноводного слоя в нормированных (а) и абсолютных (б) величинах для $n_c = 3.5$ и $\Delta = 0.09$.

носителей в активной области лазера [10] и их расчет в общем случае сложен, что делает предпочтительным непосредственное измерение указанных параметров.

Для экспериментов на длине волны 1.55 мкм использовался стандартный волоконный световод со следующими параметрами: $2a = 8$ мкм, $\Delta = 0.003$, $n_c = 1.46$, $V = 1.85$. Из (6), (7) и (9) получим: $\theta_0 = 6.1^\circ$, $2\omega_0 = 9.5$ мкм и $V_{pf} =$

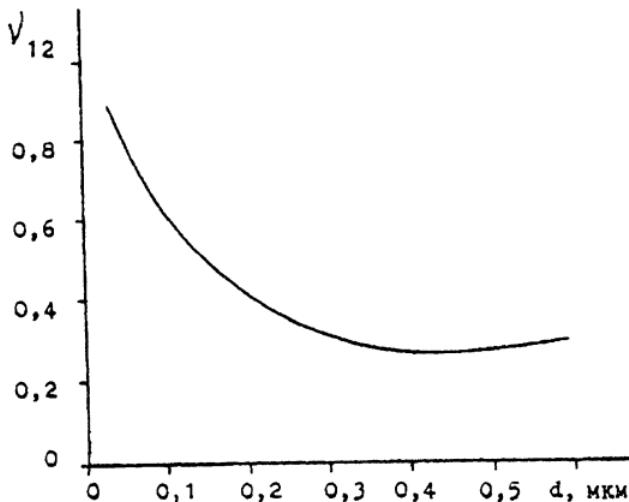


Рис. 2. Зависимость коэффициента ввода v_{12} излучения полупроводникового лазера в волоконный световод от толщины волноводного слоя лазера d .

$2.5 \text{ мкм}^2 \cdot \text{ор}$; соответствующие экспериментальные значения: $\theta_0 = 6^\circ$, $2\omega_0 = 10 \text{ мкм}$.

Волноводная область использованных в эксперименте полупроводниковых лазеров представляла собой пятислойную структуру со ступенчатым профилем показателя преломления. С учетом малой толщины квантово-размерного активного слоя ($n_a = 3.535$): $d_a \ll d$, для такой структуры справедлива модель прямоугольного волновода ($n_c = 3.472$) с однородным по показателю преломления ($n_s = 3.171$) окружением. Сравнительный анализ диаграмм направленности лазеров с различной шириной волновода W показал, что $\omega_{||} \approx \omega_0$ и $\theta_{||} \approx \theta_0$ при $W = 10 \text{ мкм}$. Для лазеров с $d = 0.45 \text{ мкм}$ и $V = 1.3$ из (8)–(10) получим: $\theta_\perp = 40^\circ$, $2\omega_\perp = 1.8 \text{ мкм}$ и $V_{ps} = 3.4 \text{ мкм}^2 \cdot \text{ср}$; соответствующие экспериментальные значения $\theta_\perp = 35^\circ$ и $2\omega_\perp = 2 \text{ мкм}$. Уменьшение толщины волновода d до значения 0.16 мкм позволяет вдвое уменьшить угловую расходимость излучения в плоскости, перпендикулярной $p-n$ -переходу: $\theta_\perp = 18^\circ$, $2\omega_\perp = 3.5 \text{ мкм}$ и $V_{ps} = 2.45 \text{ мкм}^2 \cdot \text{ор}$, что совпадает с измеренными значениями. Следовательно, методика оценки параметров волноводных структур по формулам (4)–(10), в том числе аппроксимация многослойной волноводной области таких лазеров однородным по показателю преломления прямоугольным волноводом представляется достаточно обоснованной. Расчетные значения эффективности перекачки оптической мощности из лазера с $d = 0.45 \text{ мкм}$ в волоконный световод

(1) и в обратном направлении (2) составили $\nu_{12} = 0.27$ и $\nu_{21} = 0.3$, а при $d = 0.16 \text{ мкм}$ соответственно $\nu_{12} = 0.50$ и $\nu_{21} = 0.52$, что согласуется с принципом взаимности. Расчетная величина эффективности двухстороннего согласования (3) в этих случаях составляет $\nu = 0.08$ и $\nu = 0.25$, а измеренные значения ν оказались равными 0.11 и 0.30 соответственно. Зависимость величины ν_{12} от d приведена на рис. 2.

Таким образом, предложена и экспериментально апробирована методика оценки эффективности двухстороннего согласования полупроводниковых лазеров с квантово-размерной активной областью и одномодовых волоконных световодов по их волноводным параметрам. Сравнение лазеров с различными размерами волноводной области показывает, что наибольшую эффективность двухстороннего согласования с волоконным световодом обеспечивают лазеры с широким волноводом малой толщины. Использование таких лазерных структур в солитонных информационных системах представляется предпочтительным.

Список литературы

- [1] Xасегава А.А., Кодама И. // ТИИЭР. Т. 69. № 9. С. 57–63.
- [2] Garbuзов D.Z., Berishev I.E., Lyin Yu.V., Lyinskaya N.D., Ouchinnikov A.V., Pikhtin N.A., Tarasov I.S. // J. Appl. Phys. 1992. V. 72. N 1. P. 319–321.
- [3] Андреева Е.И., Шербаков А.С., Беришев И.Э., Ильин Ю.В., Тарасов И.С. // Письма в ЖТФ. 1992. Т. 18. В. 24. С. 23–27.
- [4] Shcherbakov A.S., Andreeva E.I. // Proc. SPIE. 1993. V. 2097. P. 289–300.
- [5] Shcherbakov A.S., Ivanov O.G., Andreeva E.I. // Proc. SPIE. 1992. V. 1806. P. 44–53.
- [6] Shcherbakov A.S., Kosarsky A.Yu. // Proc. SPIE. 1994. V. 2429. P. 235–246.
- [7] Wenke G., Zhu Y. // Appl. Opt. 1983. V. 22. N 23. P. 3837–3844.
- [8] Chatak A., Sharma A. // Instr. Electronics and Telecom. Engrs. 1986. V. 32. N 4. P. 213–226.
- [9] Волноводная оптоэлектроника / Под. ред. Т.Тамира. М.: Мир, 1991. 575 с.
- [10] Горбачев А.Ю. Мощные одномодовые InGaAsP лазеры раздельного ограничения. Разработка и исследование излучательных характеристик. Канд. дис. ФТИ РАН. СПб., 1994.

Санкт-Петербургский
государственный
технический университет

Поступило в Редакцию
6 марта 1996 г.